

A101

A101はNIM1幅のスペクトロスコピアンプです。波形整形はアクティブフィルタ方式を採用し、理想のガウス整形に近づけております。最新の低雑音FETを利用したディスクリート増幅回路を採用しており、入力雑音特性を5μV以下に抑えております。アクティブゲート方式のベースラインレストアラも搭載しているので、高計数率などの測定にもご利用できます。A101は特にHPGe半導体検出器を用いた測定において、優れた分解能と直線性を実現することが可能です。

主な特徴

ゲイン	1~1500倍
波形整形	セミガウス整形 ピーキングタイム2.2τ, パルス幅6τ
雑音特性	入力換算5μV以下 2μs時 ゲイン≥100
積分非直線性	< ±0.05% 2μs時
ベースラインレストアラ	アクティブゲート方式オートスレッシュホルド
高計数率特性	ピークの広がり最大15% 2μs, 入力計数率50kcps時

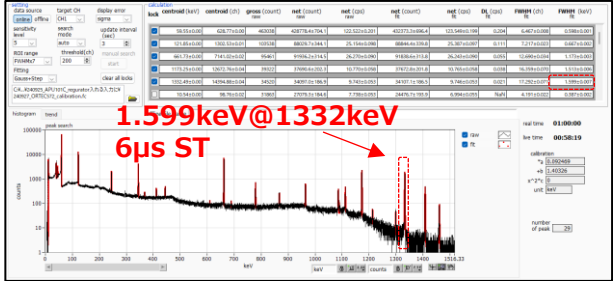
仕様

入力極性	POS(正) / NEG(負)
アッテネータ	×0.1/×1.0 内部基板のジャンパーにより切替
COARSE GAIN	×20/×50/×100/×200/×500/×1K
FINE GAIN	×0.5~×1.5
PZ ADJ	ポールゼロ調整, 40μs~∞
DC	±40mV
SHAPING TIME	0.5/ 1/ 2/ 3/ 6/ 10 μs
入力特性	レンジ: ±1.5 V, 入力インピーダンス: 1 kΩ
出力特性	正極ユニポーラ 0-10V, 駆動電流 ±100mA
BUSY OUT	TTL出力
プリアンプ電源	D-Sub9 ±12V, ±24V (NIM規格準拠) 内蔵
消費電力	+12V (300mA) +24V (40mA), -24V (30mA)
寸法・重量	NIM1幅 34(W) x 221(H) x 249(D) mm

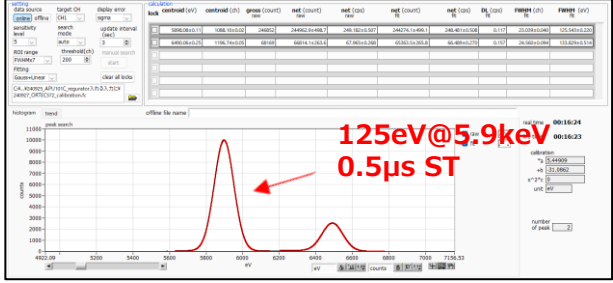


背面

HPGe半導体検出器



SDD (シリコンドリフト検出器)



※写真はイメージです。
※記載内容は予告なく変更することがあります。

